

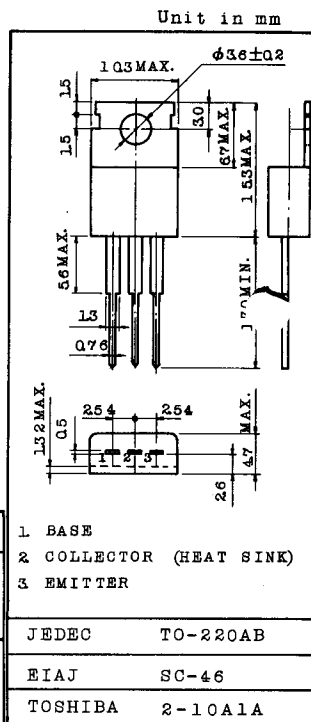
2SC1624
2SC1625

シリコンNPNエピタキシャルベースメサ形トランジスタ
SILICON NPN EPITAXIAL BASE MESA TRANSISTOR

- 中電力増幅用
- 励振段増幅用
- Medium Power Amplifier Applications
- Driver Stage Amplifier Applications
- ・ 高耐圧です。 : $V_{CEO} = 120V$ (2SC1624)
- ・ $V_{CEO} = 100V$ (2SC1625)
- ・ 2SA814, 2SA815 とコンプリメンタリになります。
- ・ Complementary to 2SA814 and 2SA815

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース 間電圧	2SC1624	V_{CBO}	120	V
	2SC1625		100	
コレクタ・エミッタ 間電圧	2SC1624	V_{CEO}	120	V
	2SC1625		100	
エミッタ・ベース間電圧		V_{EBO}	5	V
コレクタ電流		I_C	1	A
エミッタ電流		I_E	-1	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)		P_C	15	W
接合温度		T_j	150	$^\circ C$
保存温度		T_{stg}	-55~150	$^\circ C$



アクセサリは AC75 を適用
MOUNTING KIT No. AC75

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタ・シャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=50\text{V}, I_E=0$	—	—	1.0	μA
エミッタ・シャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$	—	—	1.0	μA
コレクタ・エミッタ 間降伏電圧	2SC1624	$V_{(BR)CEO}$ $I_C=10\text{mA}, I_E=0$	120	—	—	V
	2SC1625		100	—	—	
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$	.5	—	—	V
直、交流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note)	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=150\text{mA}$	70	—	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=500\text{mA}$	40	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}, I_E=50\text{mA}$	—	—	0.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=500\text{mA}$	—	—	1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=150\text{mA}$	10	30	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0$ $f=1\text{MHz}$	—	20	—	pF

Note : $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SC1624 and 2SC1625 are classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC1624 — 0 2SC1625 — 0	70	140
2SC1624 — Y 2SC1625 — Y	120	240

STATIC CHARACTERISTIC

